

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	总分
分数	30	30	40	100

1. 考试形式：闭卷；2. 本试卷共三大题，满分 100 分；

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

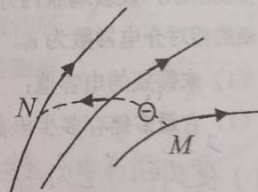
1. 根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 下列说法中，正确的是 (C)

- A、闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零； \times
- B、闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零； \times
- C、闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零；
- D、闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷

2. 如图所示为某电场的电力线分布情况。一负电荷从 M

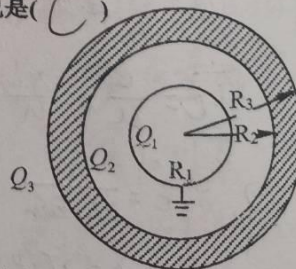
点移到 N 点，那么 (D)

- A、电场强度 $E_M > E_N$
- B、电势 $U_M > U_N$
- C、电势能 $W_M < W_N$
- D、电场力的功 $A > 0$



3. 如图所示，半径为 R_1 的导体球带有正电荷 q ，球外有一内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有正电荷 q 。将内球接地，待重新静电平衡后，内球带电 Q_1 ，球壳内表面带电 Q_2 和外表面带电 Q_3 。则 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 的情况是 (C)

- A、 $Q_1 = Q_2 = 0, Q_3 = q$
- B、 $Q_1 > 0, Q_2 = -Q_1, Q_3 = q + Q_1$
- C、 $Q_1 < 0, Q_2 = -Q_1, Q_3 = q + Q_1$
- D、 $Q_2 = -Q_1, Q_3 = 0$



4. 有两个金属球，一个是半径为 $2R$ 的中空球，另一个是半径为 R 的实心球，二球间距离 $r \gg R$ 。空心球原来电位为 V_1 ，实心球原来电位为 V_2 。若用导线将它们连接

起来, 那么两球的电位为 (C)

- A、 $V_1 + V_2$ B、 $\frac{1}{2}(V_1 + V_2)$ C、 $\frac{2}{3}V_1 + \frac{1}{3}V_2$ D、 $\frac{1}{3}V_1 + \frac{2}{3}V_2$

5. 一空气平行板电容器充电后与电源断开, 然后在两极板间充满各向同性均匀电介质, 则场强的大小 E 、电容 C 、电压 U 、电场能量 W_e 四个量各自与充入介质前相比较, 增大 (用 \uparrow 表示) 或减小 (用 \downarrow 表示) 的情形为 (D)

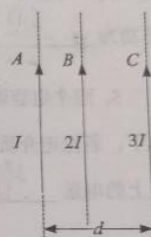
- A、 $E\downarrow, C\uparrow, U\uparrow, W_e\downarrow$ B、 $E\uparrow, C\downarrow, U\downarrow, W_e\uparrow$
C、 $E\uparrow, C\uparrow, U\uparrow, W_e\uparrow$ D、 $E\downarrow, C\uparrow, U\downarrow, W_e\downarrow$

6. 载流的圆形线圈 (半径 a_1) 与正方形线圈 (边长 a_2) 通有相同电流 I . 若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感强度大小相同, 则半径 a_1 与边长 a_2 之比 a_1/a_2 为 (D)

- A、 $1/1$ B、 $\sqrt{2}\pi/1$ C、 $\sqrt{2}\pi/4$ D、 $\sqrt{2}\pi/8$

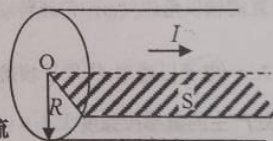
7. 三根长直载流导线 A、B、C 平行地置于同一平面内, 分别载有恒定电流 I 、 $2I$ 、 $3I$, 电流流向如右图所示. 导线 A 与 C 的距离为 d , 若使导线 B 受力为零, 则导线 B 与 A 之间的距离应为 (A)

- A、 $d/4$ B、 $3d/4$ C、 $d/3$ D、 $2d/3$



8. 在匀强磁场中, 有两个平面线圈, 其面积 $A_1 = 2A_2$, 通有电流 $I_1 = 2I_2$, 它们所受的最大磁力矩之比 M_1/M_2 等于 (C)

- A、1 B、2 C、4 D、 $1/4$



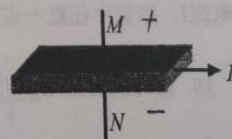
9. 一根半径为 R 的无限长直铜导线, 载有电流 I , 电流均匀分布在导线的横截面上. 在导线内部通过中心轴作一横切面 S (如上图所示), 则通过横截面 S 上每单位长度的磁通量 Φ_m 为 (B)

- A、 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ B、 $\frac{\mu_0 I}{4\pi}$ C、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi}$ D、 $\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}$

10. 如右图所示, 处在某匀强磁场中的金属块 (载流子电子) 中出现霍尔效应, 测得两底面 M 、 N 的电势差为 $V_M - V_N = 0.3 \times 10^{-3} V$, 则图中所

加匀强磁场的方向为 (C)

- A、竖直向上; B、竖直向下; C、水平向前; D、水平向后



二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 真空中平行放置两块大金属平板, 板面积均为 S , 板间距离为 d (d 远小于板面线度), 板上分别带电量 $+Q$ 和 $-Q$, 则两板间相互作用力的大小为 $\frac{Q^2}{2S\epsilon_0}$ 。
- 一点电荷 Q 位于边长为 a 的正方形平面过其中心的垂线上, Q 与平面中心 O 点相距 $a/2$, 则通过正方形平面的电通量为 $\frac{Q}{6\epsilon_0}$ 。
- 一半径为 R 的均匀带电球面, 带电量为 Q , 若规定该球面上的电势值为零, 则无限远处的电势将等于 $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。
- 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上, 放置着三个正的点电荷, 电量分别为 q 、 $2q$ 、 $3q$ 。若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处, 外力克服电场力所做的功为 $\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\epsilon_0 a}$ 。
- 两个电容器 1 和 2, 串联以后接上电动势恒定的电源充电。在电源保持连接的情况下, 若把电介质充入电容器 2 中, 则电容器 1 上的电势差 增大, 电容器 1 极板上的电量 增大。(填增大、减小、不变)
- 一半径为 R 的薄塑料圆盘, 盘面均匀分布着电荷 q , 若圆盘绕通过圆心、且与盘面垂直的轴以角速度 ω 作匀速转动时, 在盘心处的磁感应强度大小 $B = \frac{\mu_0 \omega q}{2R}$ 。
- 一电子以速率 v 绕原子核旋转, 若电子旋转的等效轨道半径为 r_0 , 则在等效轨道中心处产生的磁感应强度大小 $B = \frac{|e| \mu_0 v}{4\pi r_0^2}$ 。如果将电子绕原子核运动等效为一圆电流, 则等效电流 $I = \frac{|e| v}{2\pi r_0}$, 其磁矩大小 $p_m = \frac{|e| v r_0}{2}$ 。
- 一电子质量 m , 电量 e , 以速度 v 飞入磁感应强度为 B 的匀强磁场中, \vec{v} 与 \vec{B} 的夹角为 θ , 电子作螺旋线运动, 螺旋线螺距 $h = \frac{2\pi m v \cos \theta}{|B|e}$, 半径 $R = \frac{m v \sin \theta}{|B|e}$ 。
- 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管, 若线圈中电流 I , 则管中任意一点的磁感应强度大小为 $\frac{\mu_0 N I}{l}$ 。
- 磁介质可分为 顺磁质, 逆磁质, 铁磁质 三大类。
抗磁质

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 一无限大均匀带电平面, 电荷面密度为 $+\sigma$, 其上挖去一半径为 R 的圆孔。通过圆孔中心 O , 并垂直于平面的 X 轴上有一点 P , $OP=x$ 。试求 P 点处的场强。

解: 用补偿法求解:

题目等效为无限带电板 and 带电 $-\sigma$ 圆盘的叠加。

根据高斯定理

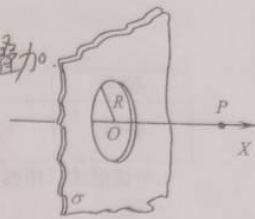
$$2E_1 \cdot \pi r^2 = \frac{\sigma \pi r^2}{\epsilon_0} \quad \therefore E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

圆盘产生的电场, 由对称性沿 X 方向。

$$dE_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma 2\pi r dr}{r^2 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\therefore E_2 = \int_0^R \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$E = E_1 - E_2 = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \quad \text{方向沿 } X \text{ 正向} \quad \vec{E} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \vec{e}$$



2. 来顿瓶是早期的一种储能电容器, 它是一内外均贴有金属薄膜的圆柱形玻璃瓶, 如图所示, 设玻璃瓶内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 内外所贴金属薄膜长为 L 。已知玻璃的相对介电常数为 ϵ_r , 其击穿场强为 E_k , 忽略边缘效应, 试计算:

(1) 来顿瓶的电容值;

(2) 它最多储存多少电荷? 最大储能是多少?

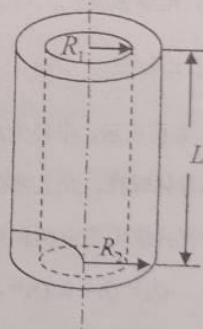
解: (1) 使内筒带电为 $+\lambda$, 外筒单位长度 $-\lambda$ 。

由高斯定理 $D \cdot 2\pi r \cdot dl = \lambda dl$

$$\therefore D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda L}{U} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



$$(2) \because E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} \quad \therefore r = R_1 \text{ 时 } E \text{ 最大} \quad \therefore E_k = \frac{\lambda}{2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\therefore \lambda = 2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r E_k \quad Q_{\max} = \lambda L = 2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r E_k L$$

$$W_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_{\max}^2}{C} = \pi \epsilon_0 \epsilon_r L R_1^2 E_k^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 一无限大均匀带电平面, 电荷面密度为 $+\sigma$, 其上挖去一半径为 R 的圆孔。通过圆孔中心 O , 并垂直于平面的 X 轴上有一点 P , $OP=x$ 。试求 P 点处的场强。

解: 用补偿法求解:

题目等效为无限带电板 and 带电 $-\sigma$ 圆盘的叠加。

根据高斯定理

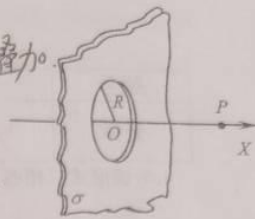
$$2E_1 \cdot \pi r^2 = \frac{\sigma \pi r^2}{\epsilon_0} \quad \therefore E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

圆盘产生的电场, 由对称性沿 X 方向。

$$dE_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma 2\pi r dr}{r^2 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\therefore E_2 = \int_0^R \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$E = E_1 - E_2 = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \quad \text{方向沿 } X \text{ 正向} \quad \vec{E} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \vec{e}$$



2. 来顿瓶是早期的一种储能电容器, 它是一内外均贴有金属薄膜的圆柱形玻璃瓶, 如图所示, 设玻璃瓶内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 内外所贴金属薄膜长为 L 。已知玻璃的相对介电常数为 ϵ_r , 其击穿场强为 E_k , 忽略边缘效应, 试计算:

(1) 来顿瓶的电容值;

(2) 它最多储存多少电荷? 最大储能是多少?

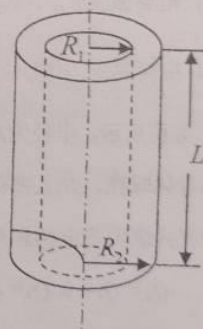
解: (1) 使内筒带电为 $+\lambda$, 外筒单位长度 $-\lambda$ 。

由高斯定理 $D \cdot 2\pi r \cdot dl = \lambda dl$

$$\therefore D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda L}{U} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



$$(2) \because E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} \quad \therefore r = R_1 \text{ 时 } E \text{ 最大} \quad \therefore E_k = \frac{\lambda}{2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\therefore \lambda = 2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r E_k \quad Q_{\max} = \lambda L = 2\pi R_1 \epsilon_0 \epsilon_r E_k L$$

$$W_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_{\max}^2}{C} = \pi \epsilon_0 \epsilon_r L R_1^2 E_k^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

3. 半径为 a 、电荷线密度为 λ ($\lambda > 0$) 的半圆形均匀带电棒, 以角速度 ω 绕轴 $O'O$ 旋转。求: (1) O 点的磁感应强度 \vec{B} ; (2) 带电棒的磁矩 \vec{p}_m 。

(提示: 积分公式: $\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \pi/2$)

解: (1) 在半圆棒上取长为 $ad\theta$ 的一段。

$$q = \lambda ad\theta \quad I = \frac{q}{T} = \frac{\omega \lambda a}{2\pi} d\theta$$

$$\text{其在 } O \text{ 点产生的磁感应强度 } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot 2\pi a \sin\theta}{a^2} \sin\theta$$

$$B = \int dB = \int_0^\pi \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 \omega \lambda}{8} \quad \text{方向由 } O'' \text{ 指向 } O'$$

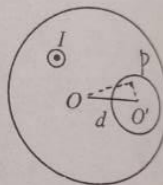
$$(2) d\vec{p}_m = I \cdot \vec{S} = \frac{\omega \lambda a}{2\pi} d\theta \cdot \pi \cdot a^2 \sin\theta = \frac{\omega \lambda a^3}{2} \sin\theta d\theta$$

$$\vec{p}_m = \int d\vec{p}_m = \int_0^\pi \frac{\omega \lambda a^3}{2} \sin\theta d\theta = \frac{\omega \lambda a^3 \pi}{4}$$

方向由 O'' 指向 O'



4. 一半径为 R 的长圆柱形导体, 在其中距其轴线为 d 处挖去一半径为 r ($r < R$)、轴线与大圆柱形导体平行的小圆柱, 形成圆柱形空腔, 导体中沿轴均匀通有电流 I , 如图所示。证明空腔内的磁感应强度 \vec{B} 是匀强磁场, 并求出 \vec{B} 。



解: 使用补像法。空腔可等效为电流密度 $j = \frac{I}{\pi R^2 - \pi r^2}$

两个电流相反导体的叠加。

此时对于空腔内任意一点 P 。

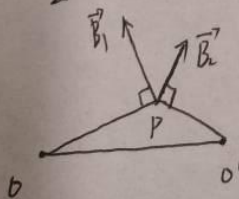
$$\text{由安培环路定理: } B_1 \cdot 2\pi |OP| = \mu_0 \cdot j \cdot \pi |OP|^2 \quad \therefore B_1 = \frac{\mu_0 j}{2} |OP|$$

其方向为以 O 为圆心 $|OP|$ 为半径圆在 P 点的切线方向, 设该方向单位向量为 \vec{a}

$$\text{同理可得 } B_2 = \frac{\mu_0 j}{2} |O'P| \quad \text{设其方向单位向量为 } \vec{b}$$

$$\therefore \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 j}{2} |OP| \vec{a} \quad \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 j}{2} |O'P| \vec{b}$$

其矢量图为



$$\therefore \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 j}{2} (|OP| \vec{a} + |O'P| \vec{b}) = \frac{\mu_0 j}{2} |OO'| \vec{c}$$

$$\text{其中 } \vec{c} \text{ 为垂直 } OO' \text{ 向上的单位向量}$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 j}{2} d \vec{c} = \frac{\mu_0 d I}{2(\pi R^2 - \pi r^2)} \vec{c}$$

方向垂直 OO' 向上